
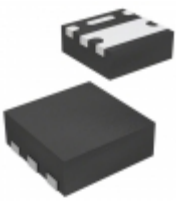







	<h2>SIA453EDJ-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA453EDJ-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 24A PPAK SC-70-6</p> <p>Datenblätter:  SIA453EDJ-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 616 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIA453EDJ-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 24A PPAK SC-70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	616 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 19W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18.5 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	66nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1900pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SIA453EDJ-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIA453EDJ-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIA453EDJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIA453EDJ-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIA459EDJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 9A SC70</p>	 <p>SIA456DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 2.6A SC70-6</p>	 <p>SIA4528-100K DELTA SIA4528-100K DELTA</p>	 <p>SIA459EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 9A SC70</p>
 <p>SIA450DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 240V 1.52A SC70-6</p>	 <p>SIA453EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 24A PPAK SC-70-6</p>	 <p>SIA456DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 2.6A SC70-6</p>	 <p>SIA4528-470K DELTA SIA4528-470K DELTA</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SIA431DJ-T1-GE3	↔ SIA432DJ-T1-GE3	⇒ SIA432DJ-T1-GE3	D SIA433EDJ	⇒ SIA433EDJ-T1-GE3
⊖ SIA433EDJ-T1-GE3	⊕ SIA436DJ-T1-GE3	D SIA436DJ-T1-GE3	⇒ SIA443DJ-T1-GE3	⇒ SIA443DJ-T1-GE3
⊕ SIA444DJ-T1-GE3	⊖ SIA444DJ-T1-GE3	⊕ SIA445EDJ-T1-GE3	↔ SIA445EDJ-T1-GE3	⇒ SIA447DJ-T1-GE3
D SIA447DJ-T1-GE3	⊕ SIA448DJ-T1-GE3	⊖ SIA448DJ-T1-GE3	⊕ SIA449DJ-GE3	⇒ SIA450DJ-T1-GE3
⇒ SIA450DJ-T1-GE3	↔ SIA4528-100K	⊕ SIA4528-330K	⊖ SIA4528-470K	⇒ SIA453EDJ-T1-GE3
↔ SIA456DJ-T1-GE3	⇒ SIA456DJ-T1-GE3	D SIA483DJ-T1-GE3	⊕ SIA483DJ-T1-GE3	⊖ SIA513DJ-T1-E3
⊕ SIA517DJ-T1-GE3	D SIA517DJ-T1-GE3	⇒ SIA517DJ-T4-GE3	↔ SIA519EDJ-T1-GE3	⇒ SIA519EDJ-T1-GE3
⊖ SIA533EDJ-T1-GE3	⊕ SIA533EDJ-T1-GE3	↔ SIA778DJ-T1-GE3	⇒ SIA778DJ-T1-GE3	⇒ SIA811ADJ-T1-GE3
⊕ SIA811ADJ-T1-GE3	⊖ SIA811DJ-T1	⊕ SIA811DJ-T1-E3	D SIA811DJ-T1-E3	⇒ SIA811DJ-T1-GE3
↔ SIA811DJ-T1-GE3	⊕ SIA813DJ-T1-GE3	⊖ SIA813DJ-T1-GE3	⊕ SIA814DJ-T1-GE3	⇒ SIA814DJ-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited